

# MA6Z121 (MA6S121)

## シリコンエピタキシャルプレーナ形

### スイッチング回路用

#### ■ 特長

- 3素子独立内蔵で高密度実装が可能
- フラットリードタイプのため、高速実装機での実装効率およびはんだ付けの向上
- 逆回復時間  $t_{rr}$  が短い
- 端子間容量  $C_t$  が小さい

#### ■ 絶対最大定格 $T_a = 25^\circ\text{C}$

項目	記号	定格	単位
逆電圧	$V_R$	80	V
最大ピーク逆電圧	$V_{RM}$	80	V
順電流 *1	$I_F$	100	mA
順電流(尖頭値) *1	$I_{FM}$	225	mA
非繰返し尖頭順サージ電流 *1, 2	$I_{FSM}$	500	mA
接合温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

注) \*1: シングルでの使用値

\*2:  $t = 1 \text{ s}$

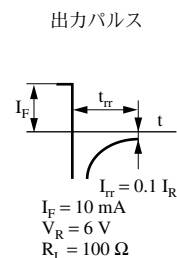
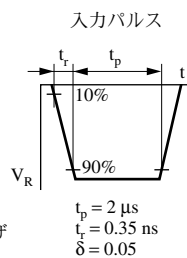
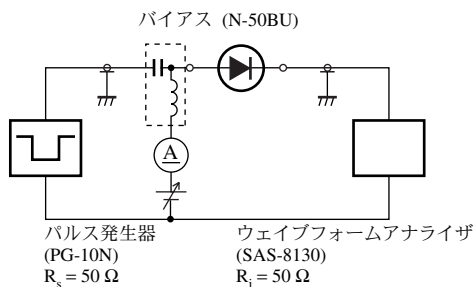
#### ■ 電気的特性 $T_a = 25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$

項目	記号	条件	最小	標準	最大	単位
順電圧	$V_F$	$I_F = 100 \text{ mA}$			1.2	V
逆電圧	$V_R$	$I_R = 100 \mu\text{A}$	80			V
逆電流	$I_R$	$V_R = 75 \text{ V}$			100	nA
端子間容量	$C_t$	$V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$			2	pF
逆回復時間 *	$t_{rr}$	$I_F = 10 \text{ mA}, V_R = 6 \text{ V}$ $I_{rr} = 0.1 I_R, R_L = 100 \Omega$			3	ns

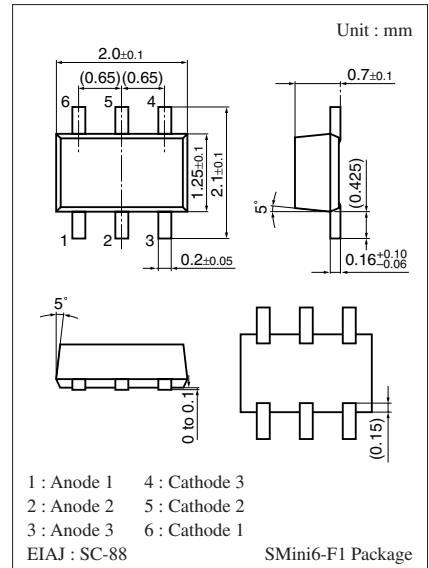
注) 1. 測定方法は、日本工業規格 JIS C 7031 ダイオード測定方法によります。

2. 定格入出力周波数: 100 MHz

3. \*:  $t_{rr}$ 測定回路



注) 形名の( )内は、従来品番です



形名表示記号: M2D

内部接続図

